

## 产品介绍

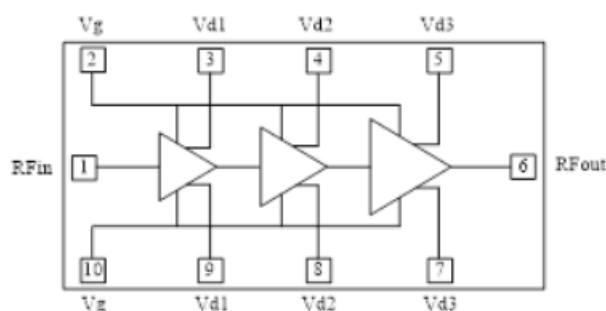
YGPA14-0618C1 是一款基于 0.25 $\mu$ m GaN HEMT工艺制作的功率放大器芯片。工作频率范围覆盖 6GHz~18GHz，功率增益大于17dB，典型饱和输出功率42dBm，典型功率附加效率23%，可在脉冲/连续波模式下工作。芯片通过背面通孔接地，典型工作电压Vd=+28V,Vg=-2.2V。

## 关键技术指标

- 频率范围：6GHz~18GHz
- 功率增益：17dB
- 饱和输出功率：42dBm
- 功率附加效率：23%
- 供电：+28V@ 2A（静态）
- 芯片尺寸：3.90 mm×3.40 mm×0.10 mm

## 应用领域

- 微波收发组件
- 固态发射机



YGPA14-0618C1 功能框图

**直流电参数 (T<sub>A</sub> = +25°C)**

指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏极工作电压	V <sub>d</sub>	-	28	32	V
栅极工作电压	V <sub>g</sub>	-3.0	-2.2	-1.8	V
静态漏极电流	I <sub>d</sub>	-	2.0	-	A
动态漏极电流	I <sub>dd</sub>	-	3.0	3.6	A
动态栅极电流	I <sub>gg</sub>	-	3.0	10.0	mA

**微波电参数 (T<sub>A</sub> = +25°C, V<sub>d</sub> = +28V, V<sub>g</sub> = -2.2V)**

指标	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	f	6~18			GHz
饱和输出功率	P <sub>sat</sub>	41.2	42.0	-	dBm
功率增益	G <sub>p</sub>	16.2	17.0	-	dB
功率增益平坦度	ΔG <sub>p</sub>	-	-	±1.5	dB
功率附加效率	PAE	-	20	-	%
线性增益	S <sub>21</sub>	-	29	32	dB
线性增益平坦度	ΔS <sub>21</sub>	-	-	±3	dB
输入驻波	VSWR(in)	-	1.7	2.2	

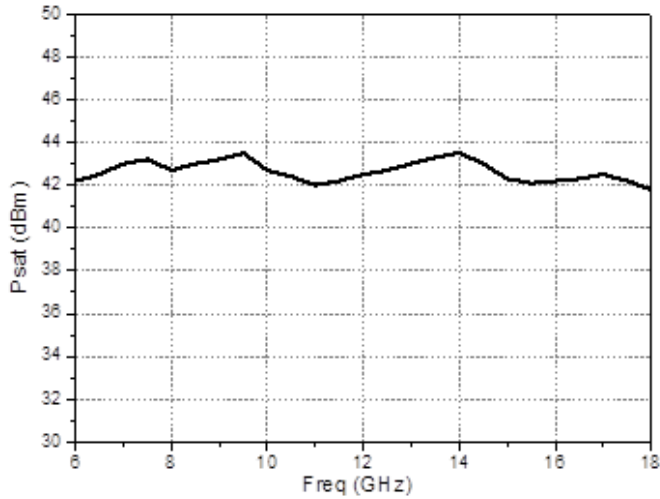
注：芯片均经过在片 100% 直流测试，100% 射频测试；

**使用限制参数**

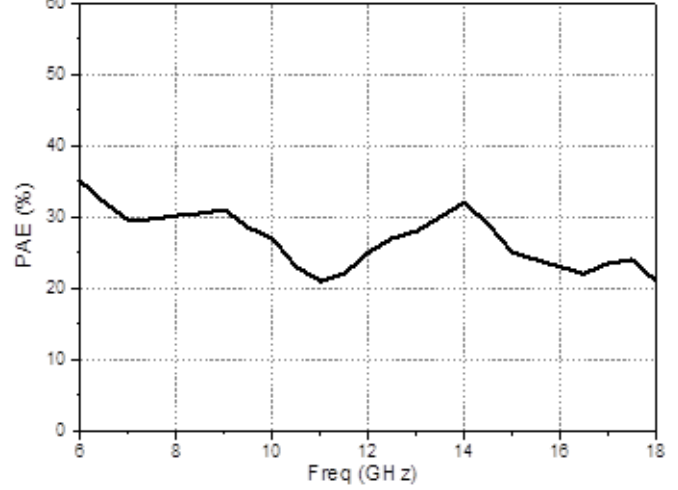
参数	符号	极限值
最大漏源正偏压	V <sub>d</sub>	+32V
最小栅极负偏压	V <sub>g</sub>	-5V
最高输入功率	P <sub>in</sub>	+28dBm
储存温度	T <sub>STG</sub>	-65°C ~ +150°C
最高工作沟道温度	T <sub>op</sub>	+225°C

典型曲线 (Vd=+28V, Vg=-2.2V)

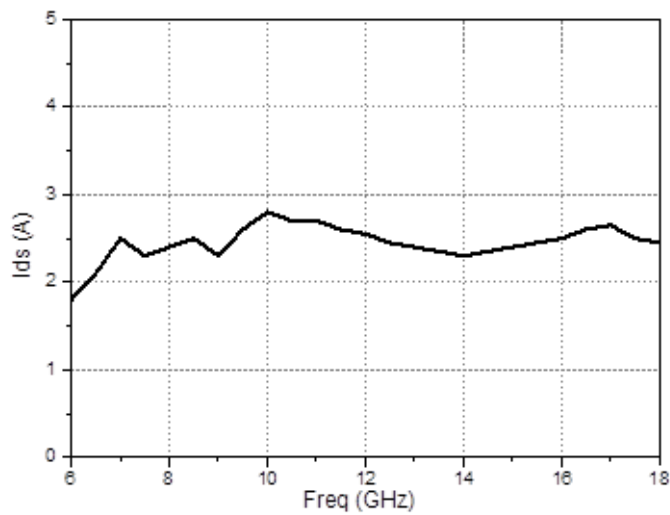
饱和输出功率 vs. 频率 (P<sub>in</sub>=25dBm)



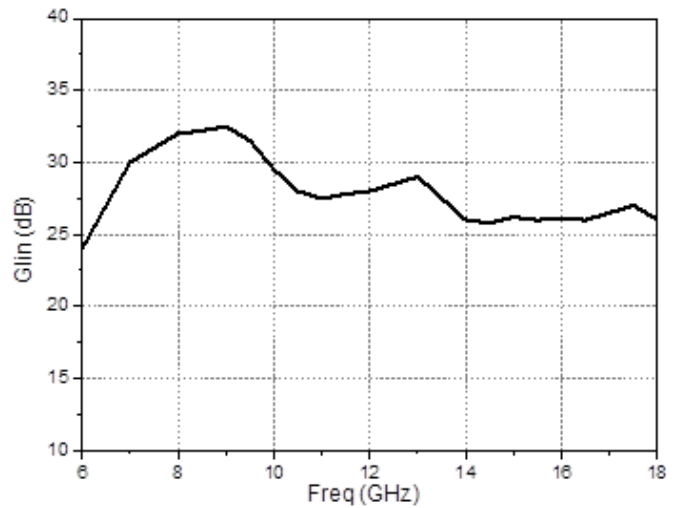
附加效率 vs. 频率 (P<sub>in</sub>=25dBm)



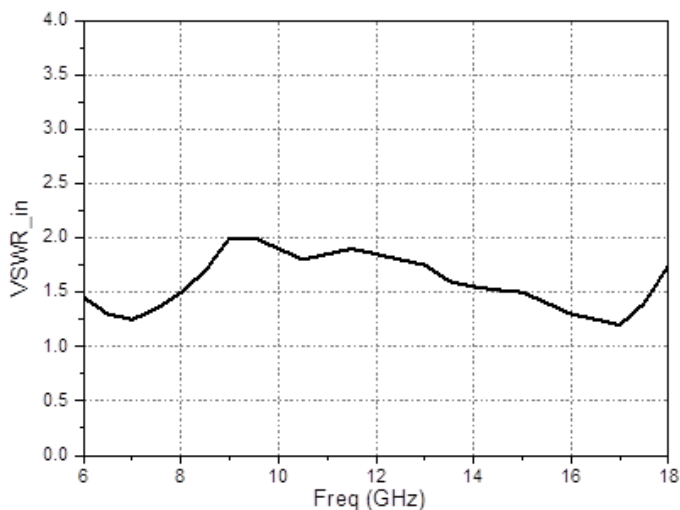
动态漏极电流 vs. 频率 (P<sub>in</sub>=25dBm)



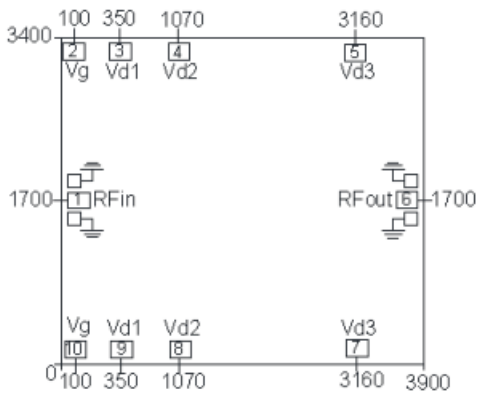
线性增益 vs. 频率 (P<sub>in</sub>=-10dBm)



输入驻波 vs. 频率 (P<sub>in</sub>=-10dBm)



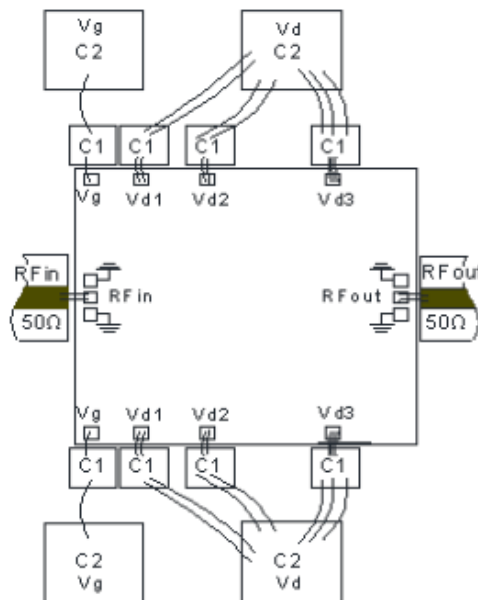
### 外形尺寸及压点排序图



序号	符号	功能	尺寸(大小)
1	RF <sub>in</sub>	信号输入端	100μm×150μm
2、10	V <sub>g</sub>	栅极电源端	120μm×100μm
3、9	V <sub>D1</sub>	漏极电源端	120μm×140μm
4、8	V <sub>D2</sub>	漏极电源端	120μm×100μm
5、7	V <sub>D3</sub>	漏极电源端	140μm×120μm
6	RF <sub>out</sub>	信号输出端	110μm×110μm

注：图中单位均为微米(μm)；  
外形尺寸公差±50μm。

### 建议装配图



注：

- 1) 外围电容的容值为 C1=100pF, C2=1000pF 推荐使用单层陶瓷电容, 其中 C1 应尽量靠近芯片, 不要超过 750μm。
- 2) 考虑 125μm~250μm 的低损低介电常数材料微带线粘接/烧结在载体上, 以降低传输损耗, 输入输出键合金丝长度控制在 350μm±150μm 以内。

## 注意事项

1. 单片电路需贮存在干燥洁净的  $N_2$  环境中；
2. 芯片衬底 6H-SiC 材料很脆，使用时必须小心，以免损伤芯片；
3. 芯片表面没有绝缘保护层，需注意装配环境洁净度，避免表面过度沾污；
4. 载体的热膨胀系数应与 6H-SiC 材料接近，线热膨胀系数  $4.2 \times 10^{-6}/^{\circ}C$ ，建议载体材料选用 CuMoCu 或 CuMo 或 CuW；
5. 装配时芯片与载体之间要避免孔洞，同时保证盒体和载体的良好散热；
6. 建议用金锡焊料烧结，Au:Sn=80%:20%，烧结温度不超过  $300^{\circ}C$ ，时间不长于 30 秒，烧结工艺避免温度快速变化，需要逐步升降温；
7. 建议使用直径  $25\mu m \sim 30\mu m$  金丝，键合台底盘温度不超过  $250^{\circ}C$ ，键合时间尽量短，键合工艺避免温度快速变化；
8. 上电时先加栅压后加漏压，去电时先降漏压后降栅压；
9. 芯片内部输入输出有隔直电容，但输入端有直流对地短路结构；
10. 芯片使用、装配过程中注意防静电，戴接地防静电手镯，烧结、键合台接地良好；
11. 有问题请与供货商联系。